

■ Product Model Reference & Naming 【產品型號參考及型號命名】

4A (Amperes)	產品型號列表、種類區分、型號對應電壓值							型號後綴字母 對應觸發電流 I _{GT} 1~3象限
	400V	600V	700V	800V	900V	1000V	1200V	
四象限非絕緣	BT136S-400D	BT136S-600D	BT136S-700D	BT136S-800D	BT136S-900D	BT136S-1000D	BT136S-1200D	"D" ≤ 5mA
四象限非絕緣	BT136S-400E	BT136S-600E	BT136S-700E	BT136S-800E	BT136S-900E	BT136S-1000E	BT136S-1200E	"E" ≤ 10mA
四象限非絕緣	BT136S-400F	BT136S-600F	BT136S-700F	BT136S-800F	BT136S-900F	BT136S-1000F	BT136S-1200F	"F" ≤ 25mA
四象限非絕緣	BT136S-400	BT136S-600	BT136S-700	BT136S-800	BT136S-900	BT136S-1000	BT136S-1200	≤ 35mA
四象限非絕緣	BT136S-400G	BT136S-600G	BT136S-700G	BT136S-800G	BT136S-900G	BT136S-1000G	BT136S-1200G	"G" ≤ 50mA
		常規品種		高壓品種	高壓品種	高壓品種	高壓品種	

BT 136 S - 600 E

型號前綴字母:
B: Bi-directional 双向
T: Triode 三端
BT: 三端双向可控硅开关
 除有特殊說明外
 所有BT字頭的產品
 均為非絕緣型品種

電流值表示:
 1306=0.6A
 131=1A
 132=1A
 134=2A
 134=4A
 136=4A
 137=8A
 138-12A
 139=16A

封裝外形表示:
 無字母: TO-92、TO-126
 SOT82、TO-220AB
X: 全塑封
 TO-220FP、SOT186A
F: 全塑封
 TO-220FP、SOT186
M、S: 片式表面貼 SMD
 SOT428、TO-252、DPAK
W: SOT-223 片式表面貼
B: TO-263、D²PAK 表面貼

電壓值表示:
 300=300V
 400=400V
 500=500V
 600=600V
 650=650V
 700=700V
 800=800V
 900=900V
 1000=1000V=1KV
 1200=1200V=1K2

觸發電流表示:
 第一象限 至 第四象限:
 I_{GT}1、I_{GT}2、I_{GT}3、I_{GT}4
 I_{GT}I、I_{GT}II、I_{GT}III、I_{GT}IV

D: 5、5、5、10 mA
 E: 10、10、10、25 mA
 F: 25、25、25、70 mA
 : 35、35、35、70 mA
 G: 50、50、50、100 mA
 除非另有說明

■ PINNING: TO-252 (SOT428 or DPAK) SMD 【TO-252貼片封裝】

Pin 管腳排列	Symbol 對應極性	Description 極性名詞	Description 極性含義	Insulated 絕緣型	Non insulated 非絕緣型	Marking 元件標識	Pin Polarity Circuit Diagram 腳位與極性 電路符號表示
1	T1	Main terminal 1	第一陽極				
2	T2	Main terminal 2	第二陽極				
3	G	Gate	門-控制極				
4	Tab	----	散熱片				
<p>◇ TO-252表面貼, 元件標識可按客戶指定要求</p> <p>◇ 2500Pcs/Reel, 2.5Kpcs/Box</p> <p>◇ 載帶卷盤包裝, 每卷2500只, 每盒1卷</p> <p>◇ 1.1g/Pcs, 每枚元件淨重1.1克</p> <p>可同時提供管裝規格, 每管80只, 每盒4000只</p>							

■ ABSOLUTE RATINGS (Limiting Values) 【額定值參數極限值】 ■ THERMAL RESISTANCES 【熱阻】 ■ 絕緣電阻特徵

SYMBOL 符號表示	Signification in Symbol 器件參數字母符號含義	Test Conditions 測試條件說明	Value 數值	Unit 單位
$I_{T(RMS)}$	通態電流均方值: On-State RMS Current (full sine wave)	$T_{mb} \leq 107^{\circ}C$	4	A
I_{TSM}	通態浪湧電流(通態不重複峰值電流): Non-Repetitive Peak on-state Current	$t=20.0mS, T_j=25^{\circ}C$	25	
		$t=16.7mS, T_j=25^{\circ}C$	27	
I_{GM}	門極峰值電流: Forward Peak Gate Current	$t=10.0mS, T_j=25^{\circ}C$	2	
I^2t	週期電流平方時間積: Circuit Fusing Consideration	$t=10.0mS, T_j=25^{\circ}C$	3.1	A^2ses
di_T / dt	通態臨界電流上升率: Repetitive rate of rise of on-state current after triggering ($I_{GT1} \sim I_{GT3}$)		50	$A/\mu s$
V_{DRM} / V_{RRM}	斷態重複峰值電壓: Repetitive peak off-state voltages	參考型號對照列表	400~1200	V
V_{GM}	門極峰值電壓: Peak gate voltage		5	
V_{isol}	引腳到外殼最大絕緣電壓: R.M.S. isolation voltage from all three terminals to external heatsink		---	
C_{isol}	陽極至絕緣片的負載電容: Capacitance from T2 to external heatsink		---	pF
$P_{G(AV)}$	門極平均散耗功率: Average gate power dissipation	Over any 20 ms period	0.5	W
P_{GM}	門極最大峰值功率: Peak gate power		5.0	
T_j	工作結溫: Operating Junction Temperature Range	Rate V_{RRM} & V_{DRM}	-40 ~ +125	$^{\circ}C$
T_{stg}	貯存溫度: Storage Temperature Range	In Free Air	-40 ~ +150	
T_L	引腳承受焊錫極限溫度: Max. Lead Temperature for Soldering Purposes 1/8	From Case for 5 Seconds	260	
$R_{th(j-mb)}$	熱阻-結到外殼: Thermal Resistance Junction to mounting base	Full Cycle: 全波	3	$^{\circ}C/W$
		Half Cycle: 半波	3.7	
$R_{th(j-a)}$	熱阻-結到環境: Thermal Resistance-Junction-to-Ambient	In Free Air	75	

■ 絕緣電阻特徵: ISOLATION LIMITING VALUE & CHARACTERISTIC ($T_{hs}=25^{\circ}C$ unless otherwise specified)

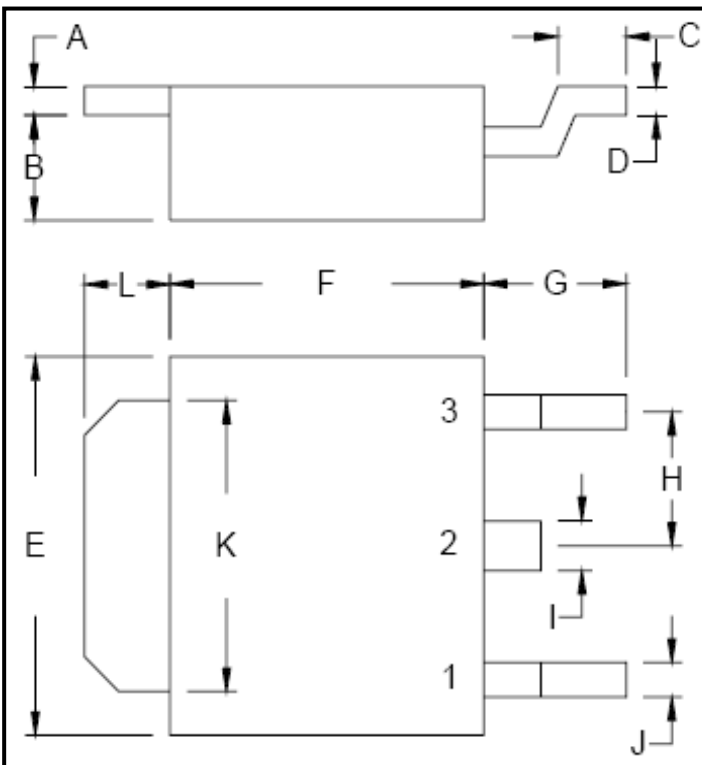
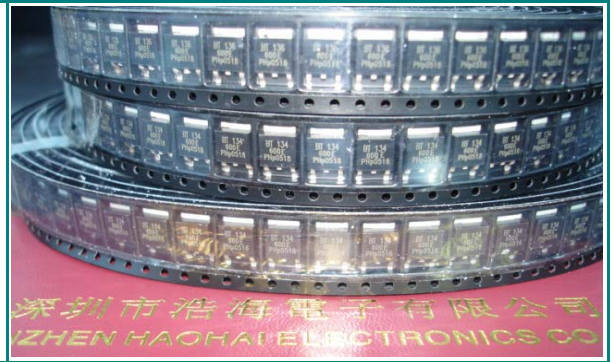
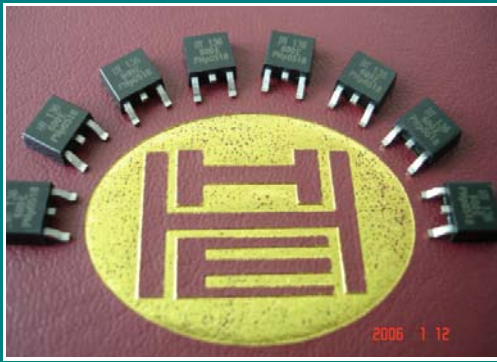
■ STATIC CHARACTERISTICS 【静态特性】 ■ DYNAMIC CHARACTERISTICS 【動態特性】

SYMBOL 符號表示	Parameter & Test Conditions 符號含義 及 參數測試條件說明	型號後綴字母所對應的各項參數值 典型值~最大值: TYP.~MAX. (單一數值為典型值)					Unit 單位	
		D	E	F	-	G		
$I_{GT I}$	門極觸發電流第一象限: T2+G+	Gate Trigger Current $T_c=25^{\circ}C$ $V_D=12V, R_L=30\Omega$	2.0~5.0	2.5~10	5.0~25	5.0~35	5.0~50	mA
$I_{GT II}$	門極觸發電流第二象限: T2+G-		2.5~5.0	4.0~10	8.0~25	8.0~35	8.0~50	
$I_{GT III}$	門極觸發電流第三象限: T2-G-		2.5~5.0	5.0~10	10~25	10~35	10~50	
$I_{GT IV}$	門極觸發電流第四象限: T2-G+		5.0~10	10~25	30~70	30~70	30~100	
I_H	維持電流: Holding Current($V_D=12V, I_{GT}=100mA$)		1.2~10	2.2~15	5.0~15	5.0~15	5.0~30	
I_L	接入電流(第三象限): Latching Current (I_{GT3})(第三象限)		1.2~10	2.5~15	5.0~20	5.0~20	5.0~30	
I_D	斷態漏電流: Off-state leakage current		0.1~0.5	0.1~0.5	0.1~0.5	0.1~0.5	0.1~0.5	
V_{GT}	門極觸發電壓: Gate trigger voltage	$V_D=12V, I_{GT}=0.1A$	0.7~1.5	0.7~1.5	0.7~1.5	0.7~1.5	0.7~1.5	V
	$I_{GT1} \sim I_{GT4}$ 全象限	$V_D=400V, I_{GT}=0.1A$	0.25~0.4	0.25~0.4	0.25~0.4	0.25~0.4	0.25~0.4	
V_{GD}	門極不觸發電壓: Gate Non-Trigger Voltage		0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	
V_{TM}	通態峰值電壓: Peak Forward On-State Voltage		1.4~1.7	1.4~1.7	1.4~1.7	1.4~1.7	1.4~1.7	
dV_D / dt	斷態臨界電壓上升率: Critical Rate of Rise of Off-State Voltage		5	50	50~250	100~250	200~250	$V/\mu s$
dV_{com} / dt	臨界轉換電壓上升率: Critical rate of change of commutating voltage		--	--	50	50	10~50	
t_{gt}	門極控制延遲時間: Gate Controlled Delay Time		2	2	2	2	2	μs
T_q	周期轉換關斷時間: Circuit Commutated Turn-off Time		--	--	--	--	--	
R_d	動態阻抗: Dynamic Resistance ($T_j=125^{\circ}C$)		--	--	--	--	--	m Ω

支持綠色環保!
該產品已實行無鉛制程封裝
符合RoHS環保指令標準!

RoHS  

PACKAGE MECHANICAL DATA (mm): TO-252 片式封裝尺寸 (單位:毫米)



單位 Dim	最小值 Min.	最大值 Max.
A	0.45	0.55
B	1.70	1.90
C	0.90	1.50
D	0.45	0.60
E	6.40	6.80
F	5.40	5.80
G	2.20	2.80
H	--	2.30
I	0.70	0.90
J	--	0.90
K	5.20	5.50
L	1.40	1.60

尺寸單位: 毫米 mm

